2D04

Ru 二核錯体と TCNQ 誘導体からなる電荷移動型集積体の 不活性種ドーピングによる電子物性制御

 (金沢大院自然¹,東北大金研²,東北大多元研³)○西尾正樹^{1,2},関根良博², 高坂 亘²,谷口耕治²,星野哲久³,芥川智行³,宮坂 等²

Control of electronic properties of charge-transferred assemblies composed of paddlewheel-type diruthenium complexes and TCNQ derivatives by doping of redox-inert units

(Kanazawa Univ.¹, IMR, Tohoku Univ.², IMRAM, Tohoku Univ.³) OMasaki Nishio^{1,2}, Yoshihiro Sekine², Wataru Kosaka², Koji Taniguchi², Norihisa Hoshino³, Tomoyuki Akutagawa³, Hitoshi Miyasaka²

【緒言】電子ドナー(D)と電子アクセプター(A)から成る集積体への混合原子価の導入は、 格子内における容易な電子ホッピングと強い磁気的相互作用が期待できるため、磁気秩序・ 伝導性を示す物質を設計する上で重要な指針である。しかし、DとAがD:A = 1:1で交互配 列した DA型一次元鎖を考えた場合、中性鎖、または完全電荷分離型のイオン性鎖の極限状 態のどちらかを安定状態とする場合が多く、一般的には混合原子価にはなり得ない。

ここで DA 型一次元鎖への混合原子価の導入法として、「電荷移動型 DA 鎖 (D⁺A⁻鎖) への不活性ユニット (P: Pinning dopant)のドーピング」を提案する。このドーピングにおいて 取り得る状態を Fig. 1 に示す。上記のように、ドーピングされていない一次元鎖では純粋な 中性 DA 状態またはイオン性 D⁺A⁻状態である。しかし、D サイトに置換する酸化還元不活性 な P ユニットをドーピングした場合、D→A の電荷移動により 2 つの P ユニットで挟まれた 1 つのドメイン内は[-P-(D⁺A⁻)_nA⁰-P-]と[-P-A⁰(D⁺A⁻)_n-P-]の 2 つの状態 (A⁰の位置が左右逆) が考えられる。すなわち、このドメイン内には必ず中性の A⁰ (ホール)が存在することとな り、ドメイン内を移動可能な A⁰/A⁻の混合原子価状態となる。一方で P の両隣の A に着目す ると、4 つの状態、[-A⁰PA⁰-]、[-A⁻PA⁻-]、[-A⁻PA⁰-]、[-A⁰PA⁻-]が考えられる。このうち後 者の 2 つの間で P ユニットを介した電子ホッピングが起こる場合は、ドメイン間の電子輸送 が可能となり伝導性が期待できる。一方で(予想ではあるが)、P によりドメイン内の電子 が閉じ込められた場合、A⁰A⁻ ↔ A⁻A⁰の双極子モーメント変化に対する誘電応答が期待でき るかもしれない。



Ig. 1. 電荷移動型 DA 一次元鎖への不活性ユニット(P)のド ピングにおける電荷状態の模式図.

BTDA-TCNOの構造.

【実験】Dとして[Ru²^{III}(4-Cl-2-MeOPhCO₂)4] ([Ru₂], 4-Cl-2-MeOPhCO₂ = 4-chloro-2-methoxybenzoate)、AとしてBTDA-TCNQ (bis(1,2,5-thiadiazolo)tetracyanoquinodimethane)を用い(Fig. 2)、 [Ru₂(4-Cl-2-MeOPhCO₂)₄(BTDA-TCNQ)]·2.5(benzene) (1)の結晶を得た。1 は各種測定から DからAに一電子移動した D⁺A⁻交互一次元鎖を形成していた(本物質系で初のイオン性 D⁺A⁻鎖を結晶として単離することに成功)。また1 は室温で安定だが、加熱真空引きすることにより脱溶媒した dry 体 (1') に結晶性を保ったまま構造相転移することがわかった。また1 を合成する際に[Ru₂]と等構造であり酸化還元不活性な[Rh₂]を混ぜて反応させることによりドー ピングサンプルを調製し、そのドープ率をICP-MSを用いて精確に決定し、Rh-x% (x = 3, 5, 16) とした。また、[Rh₂]のみを用いた反応により1のRh 体 (1-Rh)を得た。

【結果と考察】各化合物の磁化率測定を行なった。本系では、[Ru₂^{II,III}] (S = 3/2)、BTDA-TCNQ (S = 1/2)ともにスピンを持つため、 $J \approx -100$ K の反強磁性相互作用により、鎖内でフェリ磁性 スピン配向する。1 は、鎖間双極子間の反強磁性的相互作用により、 $T_N = 10.9$ K で反強磁性 転移を示した。*H-T* 相図 (Fig. 3) より、各化合物において fresh 体から dry 体にすると反強磁 性 (AF) 相が拡大する。これは、脱溶媒により鎖間距離が短くなり、その結果、鎖間双極子 –双極子相互作用が強くなったためであると解釈できる。一方で、ドープ率が上がると鎖内相 関距離が短くなり、すなわち磁気モーメントが小さくなるため、 T_N は低くなる。Rh-16%で はもはや転移を示さなかった。

次に、単結晶を用いた直流抵抗率の温度変化を調べたところ、1-Rh は絶縁体であったが、 それ以外の化合物は半導体的挙動を示した(Fig. 4)。面白いことに、ドープ率が増えると抵 抗率が減少した。また、同じく単結晶を用いた交流インピーダンス測定を行なったところ、 直流測定の場合と同じようにドープ率に比例して抵抗率が減少した。これは、P ドーピング により P…P 間のドメインで A⁰/A⁻の混合原子価状態が発現しており、ドープ量と同数のキャ リアが発生し、かつ P を介した電子ホッピングが起こった結果であると考えられる。つまり、 絶縁体である 1-Rh をドープすることにより、逆にキャリア数を増やし、伝導性を向上させる ことに成功した。



Fig. 3. 各化合物の H-T 相図.



Fig. 4. 各化合物の dc 抵抗率の温度変化.